DERWENT-ACC-NO:

1988-128697

DERWENT-WEEK:

198819

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Baking of resist film coated on semiconductor wafer - by preheating resist film, and baking to reduce bubbles in

resist film NoAbstract NoDwg
PATENT-ASSIGNEE: MITSUBISHI DENKI KK[MITQ]

PRIORITY-DATA: 1986JP-0216343 (September 12, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE March 30, 1988 LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 63070525 A APPLICATION-DATA:

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

005 APPL-DATE

PUB-NO JP 63070525A

N/A

1986JP-0216343 H01L021/30

N/A

Sep12, 1986

INT-CL (IPC): G03C005/00, G03F007/00,

ABSTRACTED-PUB-NO: EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: BAKE RESIST FILM COATING SEMICONDUCTOR WAFER PREHEAT RESIST FILM

BAKE REDUCE BUBBLE RESIST FILM NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: G06 L03 P83 P84 U11

CPI-CODES: G06-D06; G06-E; L04-C06B; L04-C16; EPI-CODES: U11-C04A1;

⑬日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-70525

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988) 3月30日

H 01 L 21/30 G 03 C 5/00 G 03 F 7/00 3 6 1 3 1 1 G-7376-5F 7267-2H

Z-7124-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

公発明の名称

途布膜の固化,形成方法

②特 顋 昭61-216343

❷出 願 昭61(1986)9月12日

⑫発 明 者

博司

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 細 1

1. 発明の名称

3. おおります。
4. おおりまする。
4. おおります。
4. おおりまする。
4. おおりままる。
4. おおりままる。
4. およりまる。
4. およりまる。</

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体落板などの被塗布膜形成面上に、塗布 膜を塗布した上で、固化処理するようにした塗布 限の固化・形成方法において、前記塗布膜の塗布 後、その固化処理前に、固化しない程度に予無す ることを特徴とする塗布膜の固化、形成方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、被塗布膜形成面に対する強布膜の 固化、形成方法に関し、さらに詳しくは、例えば 半導体素子製造時において、被塗布膜形成面とし ての半導体搭板上などに塗布形成される塗布膜の 固化、形成方法の改良に係るものである。

〔従来の技術〕

半項体案子製造時にあつて、従来,半導体基板 上などに塗布される途布膜、例えばこの場合、レ ジストとかペーストなどの塗布膜を関化、形成さ せるためには、通常、前者では、選光、現像処理 して、また、後者では、加熱処理して、それぞれ に固化させるようにしている。

(発明が解決しようとする問題点)

世で、前記のように処理されるでので変われるのように処理されるで変わられるののののののののでは、固化核の変わられているでは、固化が多ののが、のまっに残されていることが多っに、所知のできながであるなどのように、所に生じれてのできなが充分に消滅せずに固めになって、関係の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、回上層膜の形成が困難になって、

この発明は従来のこのような問題点を解消する ためになされたものであつて、その目的とすると ころは、表面形状が平滑で、かつ気孔とか気泡な どの少ない強力限を得るための、この種の流力股 の固化、形成方法を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

前記目的を達成するために、この発明に係る塗 布膜の固化、形成方法は、半導体蒸板などの被塗 布膜形成面に対して、塗布膜の塗布後、その固化 前に、固化しない程度に予熱処理した上で、固化 処理するようにしたものである。

〔作 用〕

すなわち、この発明方法においては、強和限の 塗布技、その固化前に固化しない程度に予禁する ことにより、固化前の強和膜の粘性が低下して、 塗布時に生じた気孔とか気砲などが消滅、減少さ れると共に、凹凸形状が平滑化され、その後の固 化処理によつて、所期の表面形状をもつ強和膜を 固化、形成し得るのである。

〔実 進 例〕

以下、この発明に係る徳布膜の固化、形成方法の一実施例について詳細に説明する。

この実施例方法においては、被塗布膜形成面。この場合は、半導体基板面に対して、印刷などの手段で、レジスト・ペーストなどの統布膜を塗布

表面强力が作用し易くなり、これらの作用に伴つ て、塗布時に生じた気孔とか気泡などが効果的に 稍減,減少されると共に、凹凸形状が良好に平滑 化されて、いわゆるレベリング効果を得られるの であり、また、これらの結果、その後の固化処理 によつて、所期の表面形状。すなわち気孔とか気 私などがなく、かつ平滑にレベリングされた表面 形状の塗布膜を、極めて容易に固化、形成し得る 利点を有し、そしてまた、このように形成される 塗布膜上への、その後の工程での上層膜形成に際 しても、その形成が頗る容易になるほか、塗布膜 自体の良質化によつて、例えば絶縁特性などの物 性を良好に安定化でき、併せて盤布膜自体の膜厚 をより一層薄くし得られ、しかも工程的にも比較 的簡単で、容易に実施し得るなどの優れた特長を 有するものである.

代理人 大 岩 増 雄

すなわち、この実施例方法では、固化処理に先立つて、強布膜を固化しない程度に予熱処理させることにより、この固化前の強布膜の粘性が、一旦、充分に低下されると共に、膜自体の表面が活性化されて、表面受力が作用し易くなり、これらの作用に伴つて、強布時に生じた気孔とか気をおいると共に、凹凸形状が平滑化され、その後の固化処理によつて、所期の姿面形状をもつ強布膜を固化、形成し得るのである。

〔発明の効果〕

以上詳述したようにこの発明方法によれば、半 事体基板などの被強布膜形成面に対して、強布限 の強布後、その固化前に固化しない程度に予熱処 理することにより、固化前の強布膜の粘性が、一 且、充分に低下され、かつ膜自体が活性化されて



1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-070525

(43) Date of publication of application: 30.03.1988

(51)Int.Cl.

H01L 21/30

G03C 5/00 G03F 7/00

(21) Application number : **61-216343**

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22) Date of filing: 12.09.1986

(72)Inventor: SEKI HIROSHI

(54) SOLIDIFICATION AND FORMATION OF COATING FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a coating film having the smooth surface and few pores and foams by a method wherein, after a coating film has been applied, the coating film is preheated in the degree that it is not solidified before a solidifying treatment is performed thereon.

CONSTITUTION: After the coating film such as resist, paste and the like has been applied to the surface of a semiconductor substrate using the means such as printing and the like, a preheating treatment is performed in the degree at which solidification is not generated before a solidification treatment is performed. Then, pertaining to the former (resist), the desired coating film is formed by exposure and developement, and pertaining to the latter (paste), the coating film is formed by performing a solidification treatment by applying heat, and the desired coated film is formed respectively. The viscosity of the coated film before solidification is sufficiently reduced by the above-mentioned prehating treatment, the surface tension of the film is brought into the state wherein it works easily by the activation of the surface of the film itself, and in response to the abovementioned actions, the pores and the foams generated when a coating operation is performed can be reduced or vanished, and the roughened surface can also be smoothed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision